

物理電子システム創造専攻  
平成18年度 修士中間（構想）発表会プログラム

資料

2006年6月6日版

会場：J231 2006年6月14日 発表時間：8分 質疑7分（進学者、短期修了予定者は質疑10分）

開始時間	研究室	備考	名前	題名	審査員	司会
9:30	徳光研		畑山 智裕	有機金属化学気相成長法により形成したAl <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /SiCの界面制御とデバイス応用に関する研究		山内
9:45	徳光研		高野 友一	上部バッファ層及び下部バッファ層HfAlOを用いたMIFIS構造キャパシタとデバイス応用に関する研究		
10:00	徳光研		藤村 朋史	強誘電体/ITO構造トランジスタの性能向上に関する研究		
10:15	益研		木村 実人	高密度差動伝送線路の低損失・低クロストーク化に関する研究		
10:30	休憩					
10:45	益研		川添 大輔	CMOS RF 低雑音増幅器の性能補償技術に関する研究		畑山
11:00	益研		清田 淳紀	伝送線路を用いたオンチップ高速バスの検討		
11:15	益研		山内 拓弥	小面積CMOS RF分布定数ミキサの設計		
11:30	益研		伊藤 雄作	動的再構成可能広帯域CMOS RF発振器に関する研究		
11:45	益研		上蘭 巧	統計的性能評価を用いた集積回路の製造容易化設計に関する研究		
12:00	休憩					
12:48	石原研	構想	鍾 志勇			木村
13:00	石原研		梅山 将志	強誘電体ゲートトランジスタの低電圧化に関する研究		
13:15	石原研		齋藤 貢一	2T型強誘電体メモリセルの特性評価に関する研究		
13:30	石原研		矢野 亜季	カーボンナノチューブを用いた強誘電体ゲートトランジスタの作製と評価		
13:45	筒井研		齋藤 格広	Si基板上に縦方向多段集積した弗化物共鳴トンネルデバイスの研究		
14:00	筒井研		濱島 英孝	Si基板上SrxCd1-xF2混晶の成長特性とその共鳴トンネルデバイスへの応用		
14:15	休憩					
14:30	筒井研	進学	小林 勇介	FinFETの寄生効果低減による高性能化	筒井、岩井、石原、益、大見	指導教員
14:48	岩井研	進学	館 喜一	A Study on Process Optimization of High Performance La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> gate MOSFET	石原、益、筒井、徳光、大見	指導教員
15:06	岩井研	進学	宋 在烈	A Study on Process Optimization for Ge-based Electron Devices using Rare Earth high-k Gate Dielec	石原、益、筒井、徳光、大見	指導教員
15:24	岩井研		椎野 泰洋	Novel Rare Earth Oxides Gate Stack for Advanced La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> MOSFET		齋藤格
15:29	岩井研		塩澤 崇史	Study of Reliable Ni Silicide Integration Processes for Small Scale CMOS		
15:45	休憩					
16:00	岩井研		中川 昌幸	High Frequency Model and Noise Characteristics of RF MOSFET		館
16:15	岩井研		永廣 侯治	Study of heat-resistive Ni silicide using co-deposition of various		

物理電子システム創造専攻  
平成18年度 修士中間（構想）発表会プログラム

資料

2006年6月6日版

会場：J234 2006年6月14日 発表時間：8分 質疑7分（進学者、短期修了予定者は質疑10分）

開始時間	研究室	名前	題名	審査員	司会
9:30	小林研	盛田 琢也	SOA-MZIの超高速1×2全光スイッチング動作に関する研究		鈴木
9:45	小林研	田中 紳公	透過型面型変調器の低電圧高速動作に関する研究		
10:00	小林研	城岸 直輝	GaInAs/GaAs系面発光レーザの高速直接変調特性に関する研究		
10:15	宮本研	岩崎 鷹博	トンネル注入レーザの動作特性解明とMBEによる製作		盛田
10:30	宮本研	柏原 吉浩	GaAs系面発光レーザの長波長化手法とその発振特性高性能化に関する研究		
10:45	休憩				
11:00	半那研	石松 祐輔	強誘電性を有する液晶性有機半導体の基礎物性		岡本
11:15	半那研	川島 学	液晶性有機半導体とポリマーの混合系を利用した薄膜作製と評価		
11:30	宗片研	小林 紘子	キャリア誘起強磁性に關する磁性イオンの電氣的検出法の研究		
11:45	宗片研	信谷 和隆	強磁性半導体(GaMn)Asの高品質化に関する研究		
12:00	休憩				
13:00	小山研	金澤 慈	高歪GaInAs/GaAs量子井戸レーザの高温動作に関する研究		信谷
13:15	小山研	北林 直人	面発光レーザアレイの多波長集積と合波技術に関する研究		
13:30	小山研	平野 豪	面型光変調器の帯域制御に関する研究		
13:45	植之原研	高梨 雄介	半導体光増幅器の相互位相変調特性を用いたタイミング制御型光信号再生器に関する研究		
14:00	植之原研	岡本 健資	時間分離型多波長ラベル生成器に関する研究		
14:15	納富研	佐々木 洋輔	負屈折率フォトニック結晶による光伝搬特性の制御に関する研究		
14:30	休憩				
14:45	浅田研	進学 鈴木 左文	共鳴トンネルダイオードを用いたTHz発振素子におけるカップリングアレイの研究		指導教員
15:03	浅田研	花島 君俊	共鳴トンネルダイオードを用いたTHz帯発振素子のオフセット給電スロットアンテナによる高性能化		金沢
15:18	浅田研	宮地 正人	InPショットキーバリアダイオードを用いたTHz帯ミキシング検出器に関する研究		
15:33	渡辺研	内田 薫	弗化物系サブバンド間遷移レーザのためのSOI上Plasmon導波路構造の作製		
16:48	渡辺研	小平 新志	フッ化物系サブバンド間遷移レーザにおける活性層結晶成長制御に関する研究		
16:03	渡辺研	藤井 諒	Si(100)基板上CaF <sub>2</sub> /CdF <sub>2</sub> 共鳴トンネルダイオードの集積プロセスに関する研究		

物理電子システム創造専攻  
平成18年度 修士中間（構想）発表会プログラム

資料

2006年6月6日版

会場：J231      2006年6月15日      発表時間：8分 質疑7分（進学者は質疑10分）

開始時間	研究室	名前	題名	審査員	司会
9:30	青柳研	清水 博史	深紫外発光素子用の高品質AlGaIn形成に関する研究		藤井
9:45	青柳研	藤森 文浩	短チャネル有機TFT実現のための端子制御に関する研究		
10:00	青柳研	渡辺 恒介	非線形光学材料を用いたフォトニック結晶構造の作製と光機能デバイスへの応用		
10:15	梶川研	尾崎 浩児	表面プラズモン光双安定デバイス		
10:30	梶川研	長山 哲哉	ドライプロセスを用いた金ナノ微粒子の作製		
10:45	休憩				
11:00	伊藤研	大井川 誠	スピクラスタ形成のための冷却Rb原子のスピンの偏極に関する研究		藤森
11:15	大見研	矢橋 健一	SBSIにより形成したSOI基板上へのHigh-k MOSFETの作製		
11:30	大見研	佐藤 雅樹	PtSi/HfON構造の形成とMOSFETへの応用に関する研究		